




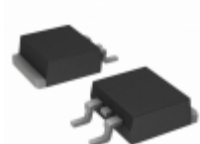




	<h2 style="color: red;">IPB054N06N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB054N06N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB054N06N3GATMA1.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 279 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPB054N06N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	279 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 58µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB054N06N3 GCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6600pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 80A (Tc) 115W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB054N06N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB054N06N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB054N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB054N06N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB055N03LG INFINEON IPB055N03LG INFINEON	 IPB054N08N3 G Infineon Technologies IPB054N08N3 G Infineon Technologies	 IPB052N04NG INF IPB052N04NG INF	 IPB054N06N3 G Infineon Technologies IPB054N06N3 G Infineon Technologies
 IPB052N04NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3	 IPB054N06N3G INF IPB054N06N3G INF	 IPB054N08N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 80A TO263-3	 IPB054N08N3G INFINEO IPB054N08N3G INFINEO

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB054N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB054N06N3GATMA1 Datenblatt	IPB054N06N3GATMA1-Datenblätter	IPB054N06N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB054N06N3GATMA1
IPB054N06N3GATMA1 Electronic	IPB054N06N3GATMA1-Komponenten	IPB054N06N3GATMA1-Verteiler	IPB054N06N3GATMA1-Bild	IPB054N06N3GATMA1-Teil
IPB054N06N3GATMA1 Preis	IPB054N06N3GATMA1 Hersteller	IPB054N06N3GATMA1 Bild	IPB054N06N3GATMA1 Aktie	IPB054N06N3GATMA1 Inventar
IPB054N06N3GATMA1 Neu	IPB054N06N3GATMA1 Original	IPB054N06N3GATMA1 garantiert	IPB054N06N3GATMA1 RFQ	IPB054N06N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited